

## COMPORTAMENTO DINAMICO DELLE GIUNZIONI P-N

Finora abbiamo affrontato situazioni stazionarie ossia ogni qualvolta che è stato necessario abbiamo posto  $\partial/\partial t = 0$  (es.  $\partial\Delta p_n/\partial t = 0$  nell'equazione di continuità).

In altre parole, abbiamo considerato la risposta della giunzione p-n ad una tensione continua (DC) e lontano dal transitorio iniziale conseguente alla sua applicazione.

Ora consideriamo la risposta della giunzione ad un segnale tempo-variante: una tensione alternata (AC) oppure un transitorio.

Fisicamente, corrisponde a tenere conto dei tempi di risposta dei portatori alla tensione di ingresso. Siccome i portatori sono di due tipi, essi hanno in generale delle dinamiche molto diverse.

I maggioritari sono "veloci" (tempi di risposta  $\sim 10^{-10}$  -  $10^{-12}$  sec) mentre i minoritari sono più lenti ( $\tau_n, \tau_p \sim 10^{-6}$  sec).

Ai processi in cui si ha una variazione della carica in risposta ad una variazione di tensione, è associato il concetto di capacità.

Pertanto, all'interno di una giunzione p-n, si possono individuare due contributi capacitivi, legati rispettivamente ai due tipi di portatori presenti:

- capacità di svuotamento  $\rightarrow$  maggioritari  $C_J$

- capacità di diffusione  $\rightarrow$  minoritari  $C_d$

Inoltre vanno considerate anche le variazioni di corrente rispetto alla tensione applicata  $\rightarrow$   $dI/dV$  conduttanza (dinamica).

Siccome il diodo è un oggetto non lineare rispetto alla tensione, capacità e conduttanza non saranno valori costanti, caratteristici del dispositivo, ma dipenderanno dal punto di lavoro  $\rightarrow$  sono definiti attraverso una formula di derivazione:

$$C = dQ/dV, \quad G = dI/dV.$$

**Problema: come risponde la giunzione ad una tensione dipendente dal tempo, definita come:**

$$v_A(t) = V_A + v_a(t)$$

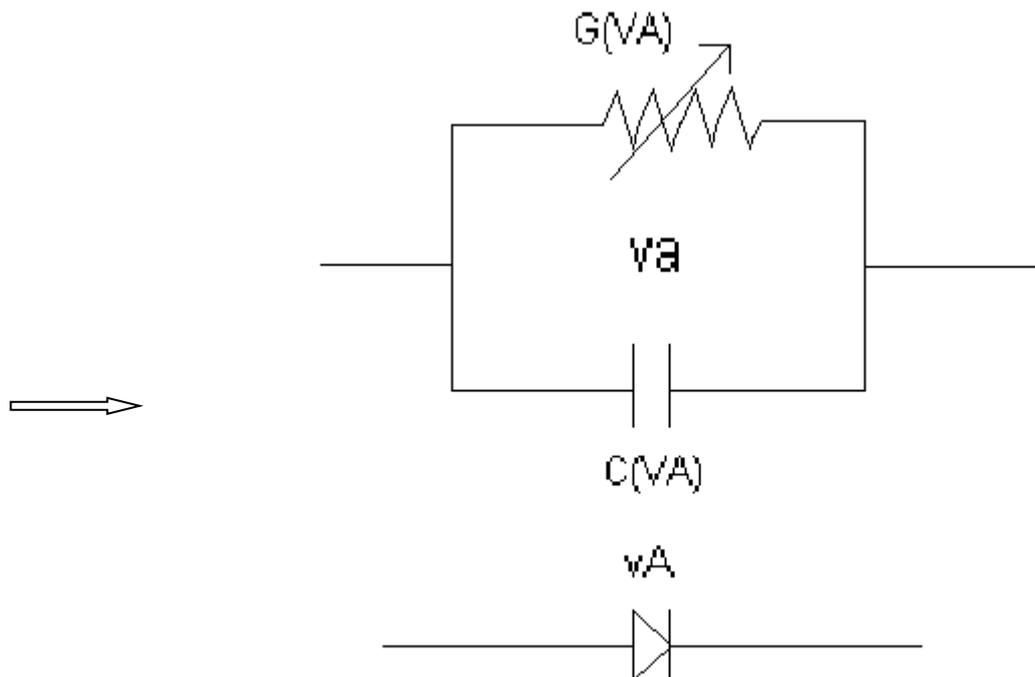
Dove  $V_A$  e' la componente continua,  $v_a$  la componente alternata di piccola ampiezza

### **Polarizzazione inversa**

Capacità di svuotamento :  $C_J$

In risposta a  $v_a$ , la zona di svuotamento si allarga o si restringe. Sono i portatori di maggioranza a muoversi e il tempo di reazione è molto basso ( $\sim 10^{-10} \div 10^{-12}$  sec)

→  $C_J$  risulta indipendente da  $\omega$  fino a frequenze molto alte ( $\sim 100$  MHz).



In inversa la giunzione si comporta come se fosse un condensatore praticamente ideale, poiché la corrente continua che attraversa il dispositivo e' praticamente nulla

-Conduttanza :  $G_0$

I portatori (di maggioranza) reagiscono istantaneamente al segnale (piccolo) sovrapposto.

In questa ipotesi:

$$I(v_A) = I_0 \left[ e^{\frac{qv_A}{kT}} - 1 \right]$$

se  $v_A = V_A + v_a$ :

$$I(V_A + v_a) = I_0 \left[ e^{\frac{q(V_A + v_a)}{kT}} - 1 \right]$$

La corrente dovuta al segnale è:

$$i = I(V_A + v_a) - I(V_A)$$

Essendo  $|v_a| \ll V_A$ ,  $I(V_A + v_a)$  può essere espanso in serie di Taylor:

$$I(V_A + v_a) \cong I(V_A) + v_a \left. \frac{dI}{dV_A} \right|_{V=V_A}$$

$$i \cong v_a \left. \frac{dI}{dV} \right|_{V=V_A}$$

$$G_0 = \frac{i}{v_a} = \left. \frac{dI}{dV} \right|_{V=V_A} \quad (\text{mhos}) \quad \text{Conduttanza a bassa frequenza}$$

$$\left. \frac{dI}{dV} \right|_{V=V_A} = I_0 \frac{q}{kT} e^{\frac{qV_A}{kT}} = \frac{q}{kT} (I + I_0)$$

Si definisce:

$$r = \frac{1}{G_0} = \frac{kT}{q(I + I_0)} \quad \text{Resistenza dinamica}$$

Se dal diodo ideale si passa al diodo reale, occorre tener conto anche del contributo dovuto alla generazione:

$$I = I_0 \left[ e^{\frac{qV_A}{kT}} - 1 \right] - \frac{qAn_i}{2\tau_0} W$$

$$\Rightarrow \frac{dI}{dV_A} = \frac{I_0 q}{kT} e^{\frac{qV_A}{kT}} - \frac{qAn_i}{2\tau_0} \frac{dW}{dV_A}$$

$$\Rightarrow G_0 = \frac{q}{kT} (I + I_0) - \frac{qAn_i}{2\tau_0} \frac{dW}{dV_A}$$

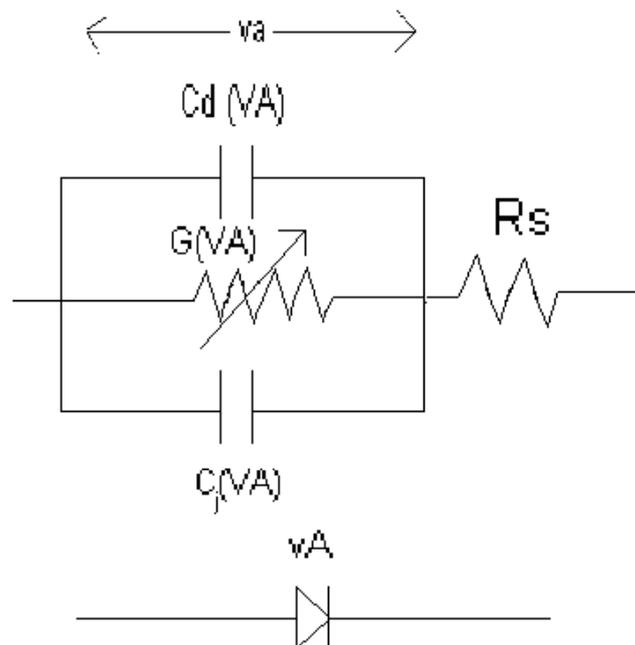
Nel caso della giunzione brusca:

$$W = \left[ \frac{2\epsilon_s}{q} (V_{bi} - V_A) \left( \frac{N_A + N_D}{N_A N_D} \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{dW}{dV_A} = \left[ \frac{2\epsilon_s}{q} \left( \frac{N_A + N_D}{N_A N_D} \right) \right]^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} \frac{(-1)}{(V_{bi} - V_A)^{\frac{1}{2}}}$$

$$G_0 = \frac{q}{kT} (I + I_0) + \frac{qAn_i}{4\tau_0} \left[ \frac{2\epsilon_s}{q} \left( \frac{N_A + N_D}{N_A N_D} \right) \frac{1}{(V_{bi} - V_A)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

## Polarizzazione diretta



Oltre a  $C_j$ , c'è anche  $C_D$  dovuta alla risposta dei minoritari. I minoritari contribuiscono anche al valore di  $G$ .

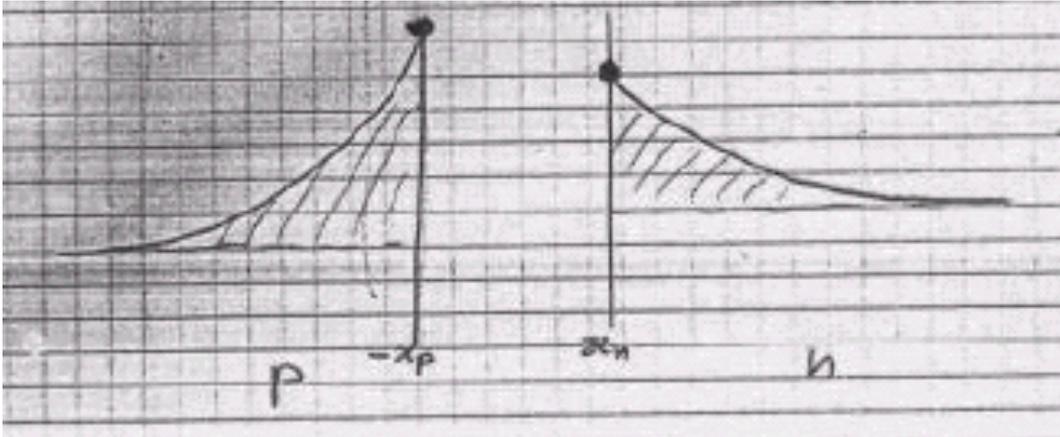
Importante: la diffusione è un processo lento rispetto alla frequenza del segnale.

Sotto l'azione di una tensione  $v_a(t)$ ,  $p_n$  (e  $n_p$ ) diventa una funzione della posizione  $\underline{e}$  del tempo:

$$p_n(x,t)$$

## Immagazzinamento di carica (charge storage)

In polarizzazione diretta, le regioni “neutre” ricevono una quantità di portatori minoritari in eccesso.



Questa carica è data da:

$$\begin{aligned} Q_p &= q \int_{x_n}^{\infty} (p_n - p_{n0}) dx \\ &= q p_{n0} \left( \exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right) \int_{x_n}^{\infty} \exp\left(-\frac{x - x_n}{L_p}\right) dx \\ &= q L_p p_{n0} \left( \exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right) \\ Q_n &= -q \int_{-\infty}^{-x_p} (n_p - n_{p0}) dx \\ &= -q L_n n_{p0} \left( \exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right) \end{aligned}$$

In una giunzione brusca asimmetrica  $N_A^+ \gg N_D^-$

$$X_p = 0 \implies Q_n = 0$$

$$J_s = q \sqrt{\frac{D_p}{\tau_p} \frac{n_i^2}{N_D}} + q \sqrt{\frac{D_n}{\tau_n} \frac{n_i^2}{N_A}} \cong$$

$$\cong q \sqrt{\frac{D_p}{\tau_p} \frac{n_i^2}{N_D}} = q \frac{D_p p_{n0}}{L_p}$$

$$Q_p = \underbrace{\frac{L_p^2}{D_p}}_{\tau_p} \underbrace{\frac{q D_p p_{n0}}{L_p}}_{J_s} \left( \exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right) = \tau_p J_p(x_n) \quad \text{eq. (3.76)}$$

## Capacità di diffusione: Basse frequenze

$$C_d = A \frac{dQ_p}{dV} = A \frac{q^2 L_p p_{n0}}{kT} e^{\frac{qV}{kT}}$$

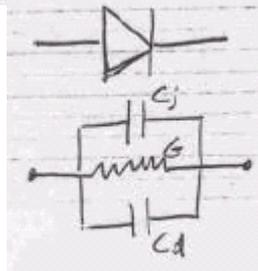
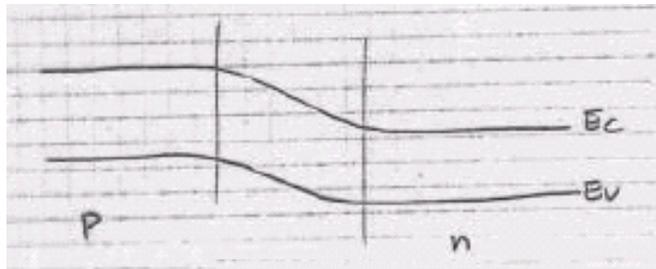
Si osservi come per  $V < 0$ ,  $C_d \longrightarrow 0$  ed infatti non vi è iniezione di minoritari nelle regioni neutre.

## Conduttanza : basse frequenze

$$G = A \frac{dJ}{dV} = A \frac{q}{kT} J_s e^{\frac{qV}{kT}}$$

$$= A \frac{q}{kT} (J + J_s) \cong A \frac{q}{kT} J = \frac{q}{kT} I$$

## Circuito equivalente:



← simbolo

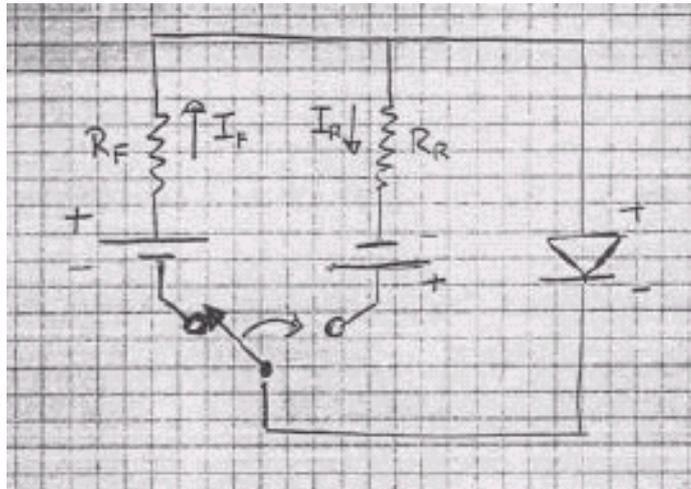
← circuito  
equivalente per  
piccoli segnali

$C_j$ ,  $C_d$ ,  $G$  dipendono da  $V$

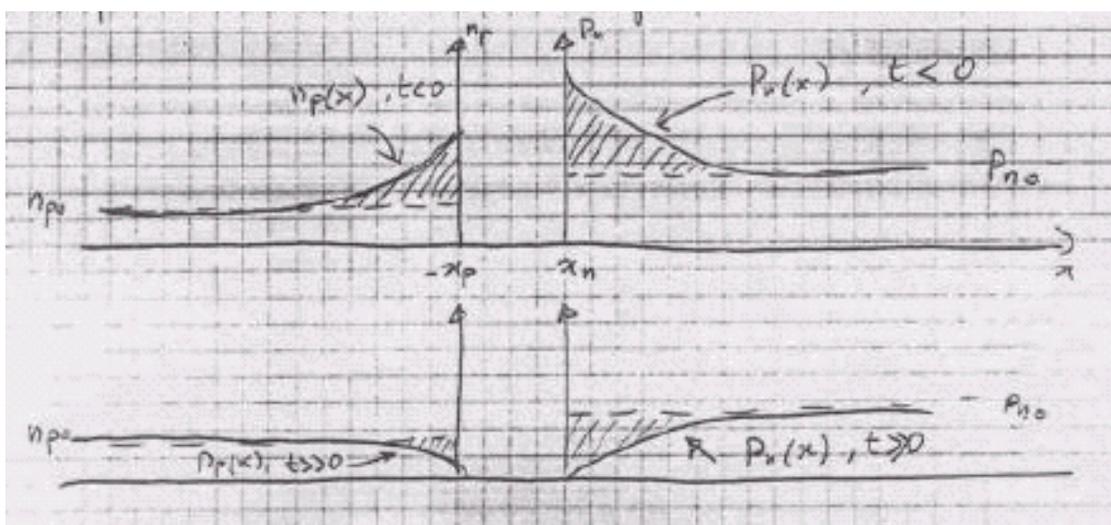
## Comportamento durante un transitorio (switching response)

Per semplicità consideriamo una giunzione p<sup>+</sup>n ( $N_A \gg N_D$ ).

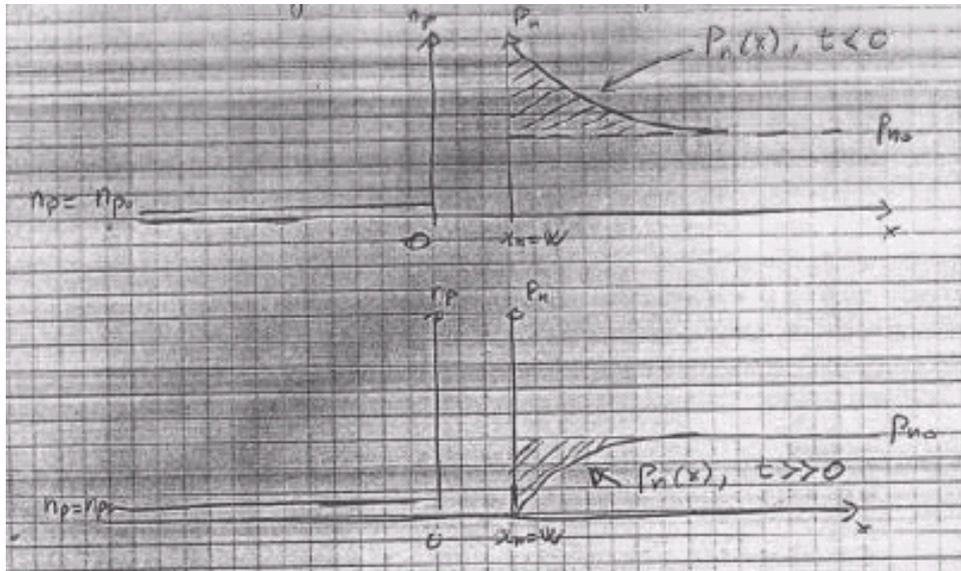
Si vuole considerare la transizione ON/OFF che si ha quando si inverte bruscamente la polarizzazione da diretta a inversa.



Questo significa studiare l'evoluzione che conduce da una situazione stazionaria di iniezione di minoritari ad una situazione, asintoticamente stazionaria, di completa "chiusura" della giunzione.



Per la giunzione brusca p+n



Come si vede, il cambiamento consiste nella “eliminazione” della carica, dovuta ai minoritari, rappresentata dalla somma delle due aree tratteggiate.

Questa eliminazione avviene tramite 2 meccanismi:

- 1) Riflusso attraverso la regione svuotata (corrente inversa);
- 2) Ricombinazione di lacune in  $x > x_n$ .

In particolare, si osserverà una diminuzione di  $p_n(x_n)$  dal suo valore iniziale  $\gg p_{n0}$  ad un valore finale  $\ll p_{n0}$ .

Il corrispondente potenziale della giunzione seguirà questo andamento

$$V_i = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{p_n(x_n, t)}{p_{n0}}\right)$$

(Si noti che, non essendo piccoli segnali, si permette a  $V_j$  di raggiungere il potenziale applicato solo come valore asintotico)

Si osservi come  $V_j$ , anche per grandi correnti, non eccede, come ordine di grandezza, il volt.

Si consideri una commutazione da +25V a -25V del circuito dato. Sia  $R_F = R_R = 1K\Omega$ , e sia  $I_S = 10^{-14}$  A.

E' facile verificare come la caduta di tensione +25V si ripartisca in circa 24,2 V su  $R_F$  e 0,8 V sul diodo, con una corrente di circa 24mA.

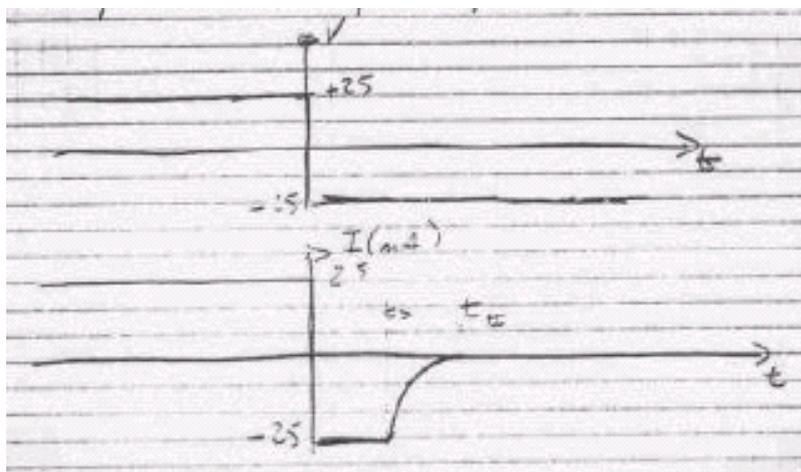
Quando avviene la commutazione, fino a che  $p_n(x_n)$  non scende fino a valori confrontabili con  $p_{n0}$ ,  $V_j$  rimane compresa tra 0,8 e 0V.

In questa fase, i -25 V devono cadere tutti sulla resistenza  $R_R$   
 $\implies$  passa una corrente  $I_R$  data da:

$$I_R = -\frac{25 + V_j}{R_R} \cong -\frac{25}{R_R} V \cong -25mA$$

Quindi, una intensa corrente costante scorre in inversa, fino al tempo  $t_s$  per cui  $p_n(x_n) \approx p_{n0}$ .

Dopo questo istante, la regione neutra non ha quasi più portatori minoritari,  $p_n(x_n)$  diventa  $\ll p_{n0}$  e  $V_j$  raggiunge rapidamente valori negativi (giunzione in inversa), fino ad uguagliare i -25V. A questo punto non passa più corrente.



$t_s$  viene definito tempo di immagazzinamento.

$t_{tt}$  ( $t_{off}$  in fig. 3.20 e eq. 3.80) viene definito tempo di transizione inversa.

## Analisi del tempo di immagazzinamento

In  $x > x_n$ , durante gli stati non stazionari:

$$\frac{\partial \Delta p_n}{\partial t} = -\frac{1}{q} \frac{\partial J_p}{\partial x} - \frac{\Delta p_n}{\tau_p} \quad \text{eq. di continuità}$$

Si moltiplichi tutto per l' area e per q e si integri tra  $x_n$  e  $\infty$ :

$$qA \frac{\partial}{\partial t} \int_{x_n}^{\infty} \Delta p_n dx = -A \int_{x_n}^{\infty} \frac{\partial J_p}{\partial x} dx - \frac{qA}{\tau_p} \int_{x_n}^{\infty} \Delta p_n dx$$

ossia

$$\frac{\partial Q_p(t)}{\partial t} = I(t) - \frac{Q_p(t)}{\tau_p} \quad \text{Equazione del controllo di carica}$$

Nel periodo  $0 \leq t \leq t_s$ ,  $I(t) = -I_R$

$$\frac{\partial Q_p}{\partial t} = -I_R - \frac{Q_p}{\tau_p}$$

$$\frac{dQ_p}{I_R + \frac{Q_p}{\tau_p}} = -dt$$

Integrando tra 0 e  $t_s$ :

$$\int_{Q_p(0)}^{Q_p(t_s)} \frac{dQ_p}{I_R + \frac{Q_p}{\tau_p}} = -\int_0^{t_s} dt$$

$$t_s = \tau_p \ln \left( \frac{I_R + \frac{Q_p(0)}{\tau_p}}{I_R + \frac{Q_p(t_s)}{\tau_p}} \right)$$

Per quanto detto si può assumere  $Q_p(t_s) \approx 0$  e, per la (3.76), (dopo aver posto  $I_F = A J_p(x_n)$ ):

$$Q_p(0) = \tau_p I_F$$

$$t_s = \tau_p \ln \left( 1 + \frac{I_F}{I_R} \right)$$

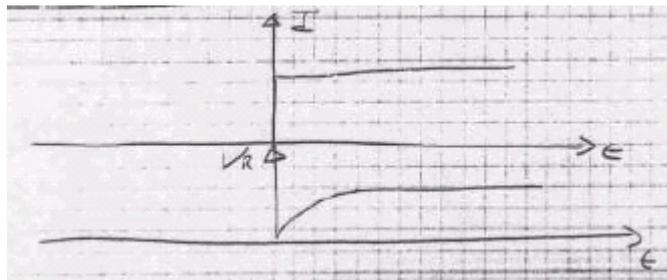
Per  $t > t_s$ , si ha una rapida discesa della corrente. Si considera chiuso il transitorio quando la corrente inversa scende a meno del 10% di  $I_R$ .

### TRANSIZIONE OFF/ON ( $I_F$ costante)

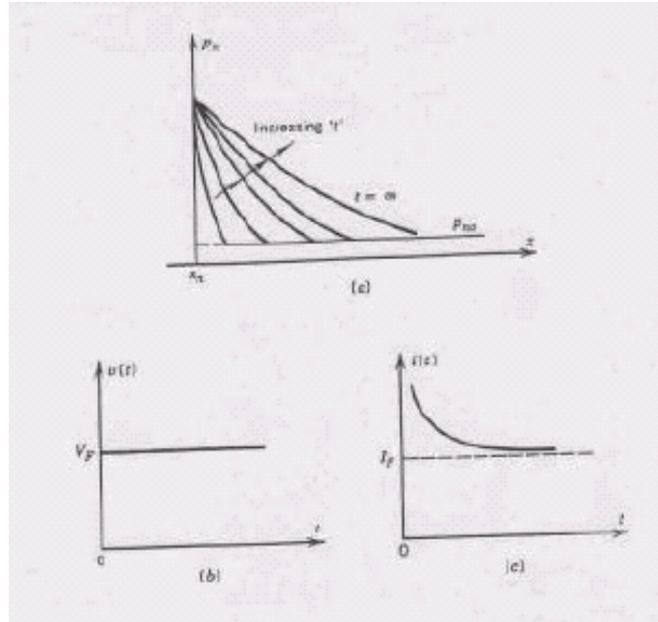
$$Q_p(t) = \tau_p I_F \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_p}} \right)$$

$$V_j(t) = \frac{kT}{q} \ln \left[ 1 + \frac{I_F}{I_S} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau_p}} \right) \right]$$

Dapprima la corrente  $I_F$  “riempie” di minoritari la regione n, poi la ricombinazione bilancia  $I_F$  e si ha uno stato stazionario.



ON  $\longrightarrow$  OFF (tensione costante)



OFF  $\longrightarrow$  ON (corrente costante)

